

(19) (KR)  
(12) (B1)

(51) 。 Int. Cl. 7  
G02F 1/136

(45)  
(11)  
(24)

2003 05 28  
10-0385762  
2003 05 17

(21) 10-2000-0040061  
(22) 2000 07 13

(65)  
(43)

2001-0015312  
2001 02 26

(30) 1999-200600 1999 07 14 (JP)

(73) 가 가 2 5 5

(72) 가 가 45 가 601

가 36-2

(74)

:

(54)

(10) , 1 (11), (12), (13), (15)  
(15) 1 (11) 2 (19) TFT ,  
(70) (28) (27)  
(71) 1 (75) , 1 (71) (13s)  
2 (72) , 1 (75) , (70)  
(73) (74) .

1  
2  
3  
< >  
10 :  
11 : 1  
13 :  
13s :  
13d :  
13c :  
14 :  
15 :  
19 : 2  
28 :  
70 :  
71 : 1  
72 : 2  
75 : 1  
76 : 2

(Thin Film Transistor : 「TFT」 ) , TFT  
(Liquid Crystal Display : 「LCD」 )  
2 , 3 2 A-A  
2 (11) (51)  
(18) (52) T  
FT가 TFT (11) (51) (13d) (52)  
(13s) (28)  
3  
1( 3 (a)) : (10) , Cr, Mo  
1 (11), SiN SiO<sub>2</sub> (12),  
(13) , 1 (11) (13c) , (13c) (13  
(13d)  
(13c) , (13c) 가 (13c)  
SiO<sub>2</sub> (14)  
(12), (13) (14) , SiO<sub>2</sub> , SiN SiO<sub>2</sub>  
(15)  
(15) (13d) (13s) (16, 17)  
(13d) (16) Al , Mo Al (18)  
(18) (13c)  
(19) , Al , Mo Al 2 (19)  
) 2 (19) , (12) (15) (20) , (10)  
(51) (52) (15)  
2 ( 3 (b)) : 1 (21)  
1 (22) , (17) 1 (23)

3 ( 3 (c)) : 1 (21) (24) (13) 2 (25) (25)  
2 (27) 2 (25) (27) 2 (32) (28)  
2 (26) (28) (13s)가 (24)  
(29)가 (28)

(21) (24) (24) 2 (29) (25) 1 (29)

1 1 1 2 2 2

2 1 1 1

가

1 2

1 2 A-A

2 (11) (51) (18) TFT가 (27)  
(52) (28) TFT (28) (28)

1 ( 1 (a)) : (51) 1 (10) , Cr, Mo  
(12) (13) (11) (13c) (13c) (13)  
(13d) (13s) (13d) (13c) 가  
(13c) SiO<sub>2</sub> (14)  
(12), (13) (14) , SiO<sub>2</sub> , SiN SiO<sub>2</sub>  
(15) (15) , SiO, SiN,

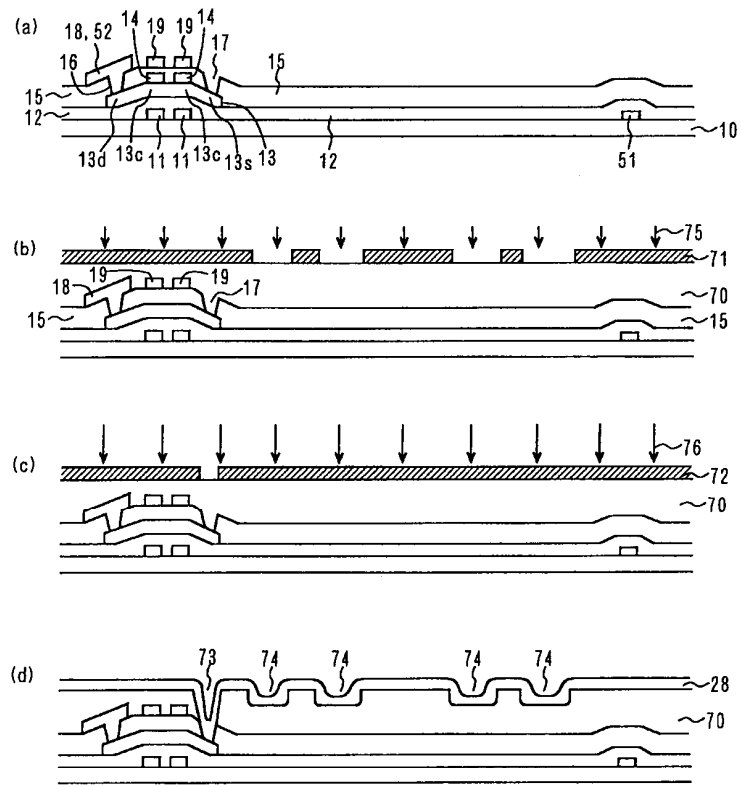
(13d), (15), (13d), (13s), (16, 17), (18)  
 (13d), (16), Al, Mo, Al (13c), (15), 2, (19)  
 (19), Al, Mo, Al, 2, (19)  
 2, (19), (12), (15), (20), (10)  
 (51), (18), (15), (18), 2  
 2 (1 (b)): (17), (15), (52), (70)  
 (19), (28), (27), 1  
 (71), 1 (75), (70), 25mJ/cm<sup>2</sup>  
 50mJ/cm<sup>2</sup>, 30mJ/cm<sup>2</sup>, 40mJ/cm<sup>2</sup>, 20mJ/cm<sup>2</sup>, 60mJ/cm<sup>2</sup>, 25mJ/cm<sup>2</sup>  
 3 (1 (c)): (13s), (71), (28), 2 (72), 2 (72),  
 (13), (13s), (28), (73)  
 2 (72), 2 (76), 2 (76), 1  
 (73), 가 (74), (73), 2 (76)  
 (13s), 가 (73), 2 (76), 200mJ/cm<sup>2</sup>, 600mJ/cm<sup>2</sup>, (76)  
 50mJ/cm<sup>2</sup>, 500mJ/cm<sup>2</sup>, 300mJ/cm<sup>2</sup>, 400mJ/cm<sup>2</sup>, 2  
 4 (1 (d)): 2 (72), (70), (70)  
 (74), (73), (73), Al  
 (28), (28), TFT, TFT  
 TFT  
 가  
 2  
 가  
 가, 220 가 (74), 가  
 (27)가, 2  
 (27)가, (51), (52)  
 (51), (52), 가 (51), (52)  
 (28), TFT  
 2 (19), (13), (14),  
 (15), (21), SiO<sub>2</sub>, SiN  
 2 TFT  
 가 1 가 3

(57)

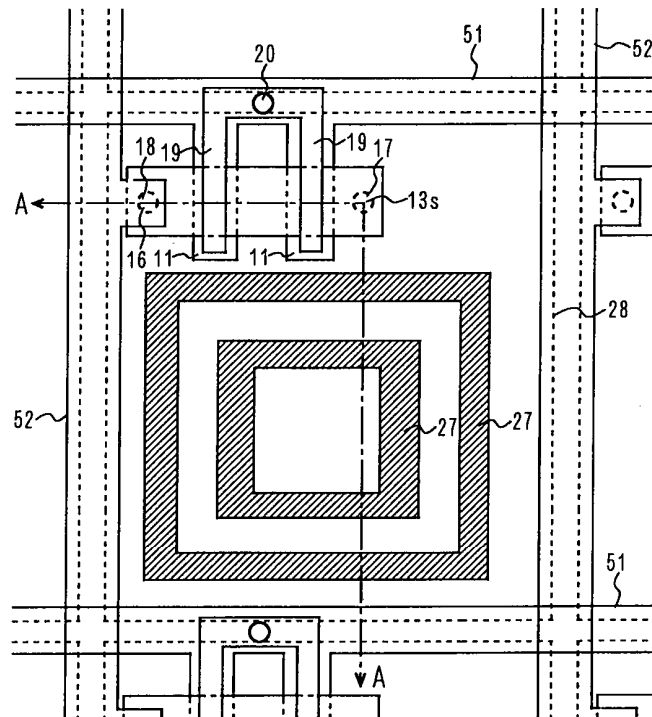
1.

,  
 ;  
 1 1 , 1 ;  
 1 , 2 , 2  
 ;  
 2 ;  
 2.  
 ,  
 ,  
 ;  
 2 , 2  
 ;  
 2 , 1 , 1 ;  
 1 , ;  
 3.  
 1 2 , , 가 가  
 4.  
 1 2 , 1 2  
 5.  
 3 , 1 2 .

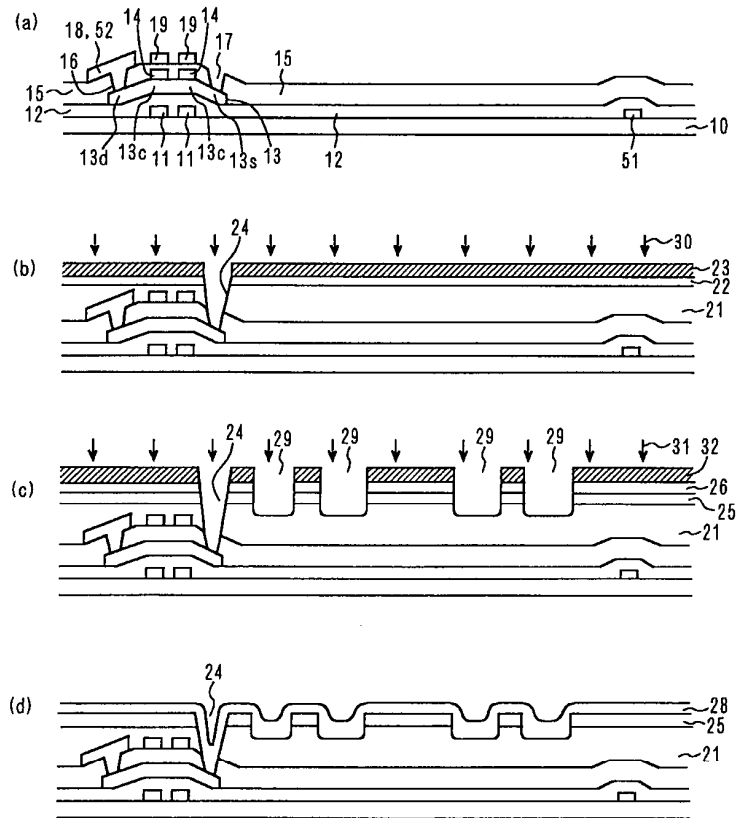
1



2



3



|                |                                                           |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 反射型液晶显示装置的制造方法                                            |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">KR100385762B1</a>                             | 公开(公告)日 | 2003-05-28 |
| 申请号            | KR1020000040061                                           | 申请日     | 2000-07-13 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 三洋电机株式会社<br>山洋电气株式会社                                      |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 三洋电机有限公司是分租                                               |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 三洋电机有限公司是分租                                               |         |            |
| [标]发明人         | NORITAKE KAZUTO<br>노리타케가즈토<br>YAMAJI TOSHIFUMI<br>야마지도시후미 |         |            |
| 发明人            | 노리타케가즈토<br>야마지도시후미                                        |         |            |
| IPC分类号         | G02F1/1362 G02F1/1368 G09F9/30 G02F1/1335 G02F1/136       |         |            |
| CPC分类号         | G02F1/133553 G02F1/136227                                 |         |            |
| 代理人(译)         | CHANG, SOO KIL                                            |         |            |
| 优先权            | 1999200600 1999-07-14 JP                                  |         |            |
| 其他公开文献         | KR1020010015312A                                          |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                 |         |            |

### 摘要(译)

本发明提供一种反射型液晶显示装置的制造方法，该反射型液晶显示装置容易在反射显示电极与反射型显示电极形成区域中的源极和凹陷部分之间形成接触孔，同时抑制工艺的增加。在绝缘基板10上形成第一栅电极11，栅极绝缘膜12，半导体膜13和层间绝缘膜15，通过形成包括连接到电极11的第二栅电极19并将光敏树脂70施加到整个表面的TFT，在形成反射显示电极28的区域中形成凹槽27，利用掩模71执行第一曝光75，掩模71包括在对应于源13s的位置处的开口，以及在对应于源13s的位置处具有开口的第二掩模72，而不是第一掩模71。通过以大于第一次曝光75的曝光量的曝光量曝光来显影光敏树脂膜70，

